(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年10月2日(02.10.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/204648 A1

(51) 国際特許分類:
B23Q 11/00 (2006.01)　*B24B 41/06* (2012.01)
B23B 25/00 (2006.01)　*B24B 55/06* (2006.01)
B23D 5/02 (2006.01)　*G11B 5/73* (2006.01)
B23Q 3/08 (2006.01)　*G11B 5/82* (2006.01)
B23Q 7/04 (2006.01)　*G11B 5/84* (2006.01)
B24B 1/00 (2006.01)

(21) 国際出願番号：　PCT/JP2025/008045

(22) 国際出願日：　2025年3月5日(05.03.2025)

(25) 国際出願の言語：　日本語

(26) 国際公開の言語：　日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-048654　2024年3月25日(25.03.2024)　JP
特願 2024-193629　2024年11月5日(05.11.2024)　JP

(71) 出願人: 株式会社レゾナック・ハードディスク(**RESONAC HARD DISK CORP.**) [JP/JP]; 〒2900067 千葉県市原市八幡海岸通５番地１ (JP).

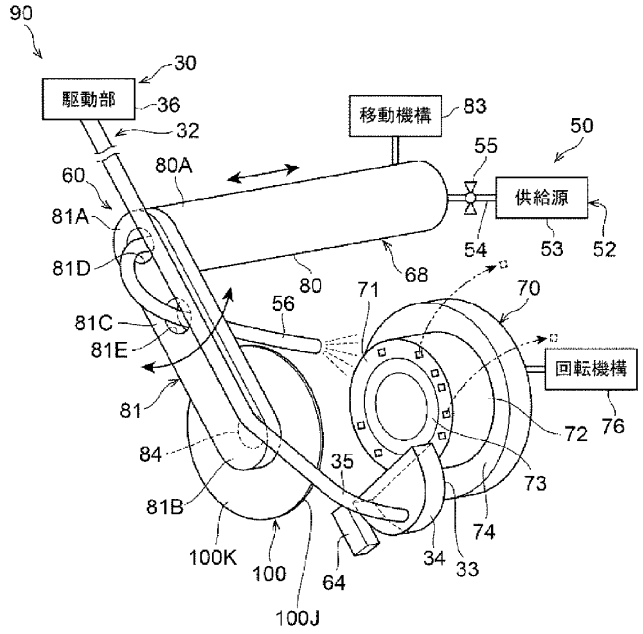
(72) 発明者: 小室　満広 (**KOMURO, Mitsuhiro**); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目９番１号 株式会社レゾナック内 (JP). 久志野　高宏(**KUSHINO, Takahiro**); 〒3238678 栃木県小山市犬塚１丁目４８０番地 株式会社レゾナック・ハードディスク内 (JP).

(74) 代理人: 弁理士法人太陽国際特許事務所(**TAIYO, NAKAJIMA & KATO**); 〒1600022 東京都新宿区新宿４丁目３番１７号 (JP).

WO 2025/204648 A1

(54) **Title:** PRODUCTION METHOD FOR DISK-SHAPED SUBSTRATE AND PRODUCTION DEVICE FOR DISK-SHAPED SUBSTRATE

(54) 発明の名称： 円盤状基板の製造方法、及び円盤状基板の製造装置



36 Drive part
53 Supply source
76 Rotation mechanism
83 Movement mechanism

(57) **Abstract:** According to the present invention, a production method for a disk-shaped substrate includes a first step for supplying a fluid to a suction surface of a suction part that is to suction one surface of a disk-shaped substrate during a period in which the disk-shaped substrate is not being suctioned and removing foreign matter that has adhered to the suction surface, a second step for sucking up the foreign matter removed from the suction surface while the fluid supply of the first step is being performed, a third step for suctioning the one surface of the disk-shaped substrate onto the suction

［続葉有］

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能):AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能):ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

surface to which the fluid has been supplied, and a fourth step for performing at least one process selected from among a cutting process, a grinding process, and a polishing process on the disk-shaped substrate that has been suctioned onto the suction surface.

(57) 要約:円盤状基板の製造方法は、円盤状基板の一方の面を吸着する吸着部の吸着面に対し、前記円盤状基板が吸着されていない期間において流体を供給し、当該吸着面に付着した異物を除去する第一工程と、前記吸着面から除去された異物を、前記第一工程における前記流体の供給を実行しながら吸引する第二工程と、前記流体が供給された吸着面に前記円盤状基板の一方の面を吸着させる第三工程と、前記吸着面に吸着された円盤状基板に対して、切削処理、研削処理及び研磨処理からなる群より選択される少なくとも一つの処理を実行する第四工程と、を備える。